
	<h2>SIA477EDJT-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIA477EDJT-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 12V 12A SC70-6</p> <p>Datenblätter:  SIA477EDJT-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 78 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	




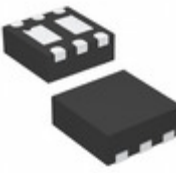



Spezifikationen

Teilenummer	SIA477EDJT-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 12V 12A SC70-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	78 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6 Single
Serie	TrenchFET® Gen III
Rds On (Max) @ Id, Vgs	13 mOhm @ 5A, 4.5V
Verlustleistung (max)	19W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6
Andere Namen	SIA477EDJT-T1-GE3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3050pF @ 6V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	50nC @ 4.5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 12V 12A (Tc) 19W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Tc)

SIA477EDJT-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIA477EDJT-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIA477EDJT-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIA477EDJT-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIA472EDJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 12A SC70-6</p>	 <p>SIA477EDJ-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 12V 12A SC-70-6L</p>	 <p>SIA483DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 12A SC70-6</p>	 <p>SIA469DJ-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 12A SC70-6</p>
 <p>SIA511DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 12V 4.5A SC70-6</p>	 <p>SIA477EDJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 12A SC-70-6L</p>	 <p>SIA483DJ-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 12A SC70-6</p>	 <p>SIA477EDJT-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 12V 12A SC70-6</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIA477EDJT-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIA477EDJT-T1-GE3 Datenblatt	SIA477EDJT-T1-GE3-Datenblätter	SIA477EDJT-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIA477EDJT-T1-GE3
SIA477EDJT-T1-GE3 Electronic	SIA477EDJT-T1-GE3-Komponenten	SIA477EDJT-T1-GE3-Verteiler	SIA477EDJT-T1-GE3-Bild	SIA477EDJT-T1-GE3-Teil
SIA477EDJT-T1-GE3 Preis	SIA477EDJT-T1-GE3 Hersteller	SIA477EDJT-T1-GE3 Bild	SIA477EDJT-T1-GE3 Aktie	SIA477EDJT-T1-GE3 Inventar
SIA477EDJT-T1-GE3 Neu	SIA477EDJT-T1-GE3 Original	SIA477EDJT-T1-GE3 garantiert	SIA477EDJT-T1-GE3 RFQ	SIA477EDJT-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited